

## 英飞凌 CoolSiC™

400V CoolSiC™ G2 MOSFET

### 特性

- 非常适合高频开关和同步整流
- 具有低  $Q_{fr}$  值与换向鲁棒性的快速体二极管
- 低  $R_{DS(on)}$  温度依赖性
- 基准栅极阈值电压,  $V_{GS(th)} = 4.5V$
- 建议栅极驱动电压 0V 至 18V
- .XT 互连技术, 实现行业领先的热性能
- 100% 雪崩测试

### 潜在应用

- SMPS
- 太阳能逆变器
- 储能, UPS 和电池化成
- D类功放
- 电机驱动

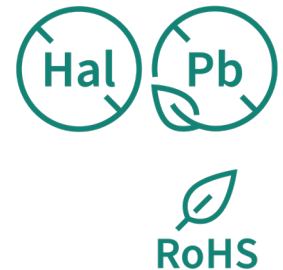
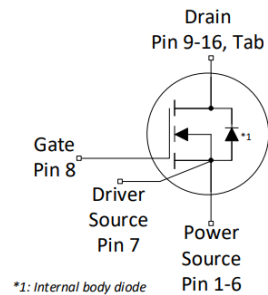
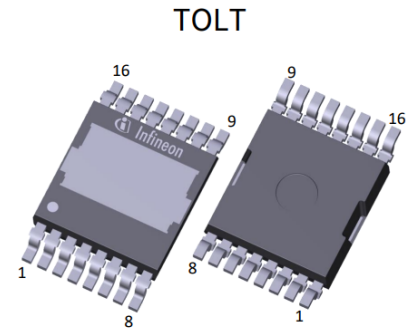
### 产品验证

依据 JEDEC JESD47、JESD22 和 J-STD-020 相关测试, 符合工业级应用要求。

表 1 主要性能参数

Parameter	Value	Unit
$V_{DS}$	400	V
$R_{DS(on),typ}$	36.4	mΩ
$I_D$	50	A
$Q_{oss}$	42	nC
$E_{oss}$	3.0	μJ
$Q_G$	26	nC

Part number	Package	Marking	Related links
IMLT40R036M2H	PG-HDSOP-16	40R036M2	-





## 目录

描述.....	1
最大额定值 .....	3
热特性.....	4
工作范围 .....	4
电气特性 .....	5
电气特性图.....	7
测试电路 .....	13
封装外形 .....	14
修订记录 .....	17
商标.....	18
免责声明.....	18

## 1 最大额定值

除非另有规定， $T_A=25\text{ °C}$

表 2 最大额定值

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test condition
		Min.	Typ.	Max.		
Continuous drain current <sup>1)</sup>	$I_D$	-	-	50	A	$V_{GS}=18\text{ V}, T_C=25\text{ °C}$
				36		$V_{GS}=18\text{ V}, T_C=100\text{ °C}$
Pulsed drain current <sup>2)</sup>	$I_{D,pulse}$	-	-	150	A	$T_C=25\text{ °C}$
Avalanche energy, single pulse <sup>3)</sup>	$E_{AS}$	-	-	66	mJ	$I_D=11.1\text{ A}, R_{GS}=25\text{ }\Omega$
Avalanche energy, repetitive	$E_{AR}$			0.33		
Gate source voltage (static)	$V_{GS,DC}$	-7	-	23	V	-
Gate source voltage (transient)	$V_{GS,AC}$	-10	-	25	V	$t_{pulse}\leq 500\text{ ns}, \text{ duty cycle}\leq 1\%$
Power dissipation	$P_{tot}$	-	-	167	W	$T_C=25\text{ °C}$
Storage temperature	$T_{stg}$	-55	-	150	°C	-
Operating junction temperature	$T_j$			175		

- 1) 额定值的适用条件：产品在数据手册中规定的绝对最大值条件下运行、确保外壳温度为 $25\text{ °C}$ 更高的外壳温度请参见图 2。需要根据实际环境条件降低额定值。
- 2) 详细信息请参见图 3
- 3) 详细信息请参见图 19

## 2 热特性

表 3 热特性

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test condition
		Min.	Typ.	Max.		
Thermal resistance, junction - case	$R_{thJC}$	-	-	0.9	°C/W	-

## 3 工作范围

表 4 工作范围

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test condition
		Min.	Typ.	Max.		
Recommended turn-on voltage	$V_{GS(on)}$	-	18	-	V	-
Recommended turn-off voltage	$V_{GS(off)}$	-	0	-		

## 4 电气特性

除非另有规定,  $T_j=25\text{ }^\circ\text{C}$

表 5 静态特性

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test condition
		Min.	Typ.	Max.		
Drain-source breakdown voltage	$V_{(BR)DSS}$	400	-	-	V	$V_{GS}=0\text{ V}, I_D=0.4\text{ mA}$
Gate threshold voltage <sup>4)</sup>	$V_{GS(th)}$	3.5	4.5	5.6	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=4\text{ mA}$
Zero gate voltage drain current	$I_{DSS}$	-	1	75	$\mu\text{A}$	$V_{DS}=400\text{ V}, V_{GS}=0\text{ V}, T_j=25\text{ }^\circ\text{C}$
			2	-		$V_{DS}=400\text{ V}, V_{GS}=0\text{ V}, T_j=175\text{ }^\circ\text{C}$
Gate-source leakage current	$I_{GSS}$	-	1	100	nA	$V_{GS}=20\text{ V}, V_{DS}=0\text{ V}$
Drain-source on-state resistance	$R_{DS(on)}$	-	36.4	45.7	m $\Omega$	$V_{GS}=18\text{ V}, I_D=11.1\text{ A}, T_j=25\text{ }^\circ\text{C}$
			52.4	-		$V_{GS}=18\text{ V}, I_D=11.1\text{ A}, T_j=175\text{ }^\circ\text{C}$
			44.6	-		$V_{GS}=15\text{ V}, I_D=11.1\text{ A}, T_j=25\text{ }^\circ\text{C}$
Gate resistance	$R_G$	-	5.5	-	$\Omega$	-

4) 在  $V_{GS}=+20\text{ V}$  时, 施加 1 ms 脉冲后进行测试。

表 6 动态特性

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test condition
		Min.	Typ.	Max.		
Input capacitance	$C_{iss}$	-	870	-	pF	$V_{GS}=0\text{ V}, V_{DS}=200\text{ V}, f=1\text{ MHz}$
Output capacitance	$C_{oss}$	-	120	-		
Reverse transfer capacitance	$C_{rss}$	-	10	-		
Effective output capacitance, energy related <sup>5)</sup>	$C_{o(er)}$	-	150	-	pF	$V_{GS}=0\text{ V}, V_{DS}=0\dots200\text{ V}$
Effective output capacitance, time related <sup>6)</sup>	$C_{o(tr)}$	-	210	-	pF	$I_D=\text{constant}, V_{GS}=0\text{ V}, V_{DS}=0\dots200\text{ V}$
Turn-on delay time <sup>7)</sup>	$t_{d(on)}$	-	13.0	-	ns	$V_{DD}=200\text{ V}, V_{GS}=0\dots18\text{ V}, I_D=11.1\text{ A}, R_{G,ext}=1.8\text{ }\Omega$
Rise time <sup>7)</sup>	$t_r$	-	11.9	-		
Turn-off delay time <sup>7)</sup>	$t_{d(off)}$	-	17.9	-	ns	$V_{DD}=200\text{ V}, V_{GS}=18\dots0\text{ V}, I_D=11.1\text{ A}, R_{G,ext}=1.8\text{ }\Omega$
Fall time <sup>7)</sup>	$t_f$	-	8.1	-		

5)  $C_{o(er)}$  是一个固定电容, 其储存能量与  $C_{oss}$  相同, 当  $V_{DS}$  从 0 上升至 200 V。

6)  $C_{o(tr)}$  是一个固定电容, 其充电时间与  $C_{oss}$  相同, 当  $V_{DS}$  从 0 上升至 200 V。

7) 测试设置请参见表 9。

表 7 栅极电荷特性<sup>8)</sup>

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test condition
		Min.	Typ.	Max.		
Gate to source charge	$Q_{gs}$	-	7	-	nC	$V_{DD}=200\text{ V}$ , $I_D=11.1\text{ A}$ , $V_{GS}=0\text{ to }18\text{ V}$
Gate to drain charge	$Q_{gd}$	-	5.4	-		
Gate charge total	$Q_g$	-	26	-		
Gate charge total, sync. FET	$Q_{g(sync)}$	-	24	-	nC	$V_{DS}=0.1\text{ V}$ , $V_{GS}=0\text{ to }18\text{ V}$
Output charge	$Q_{oss}$	-	42	-	nC	$V_{DS}=200\text{ V}$ , $V_{GS}=0\text{ V}$
Output Energy	$E_{oss}$	-	3.0	-	$\mu\text{J}$	

<sup>8)</sup> 依据 JEP192, SiC MOSFET 栅极电荷 ( $Q_G$ ) 测试方法指南。

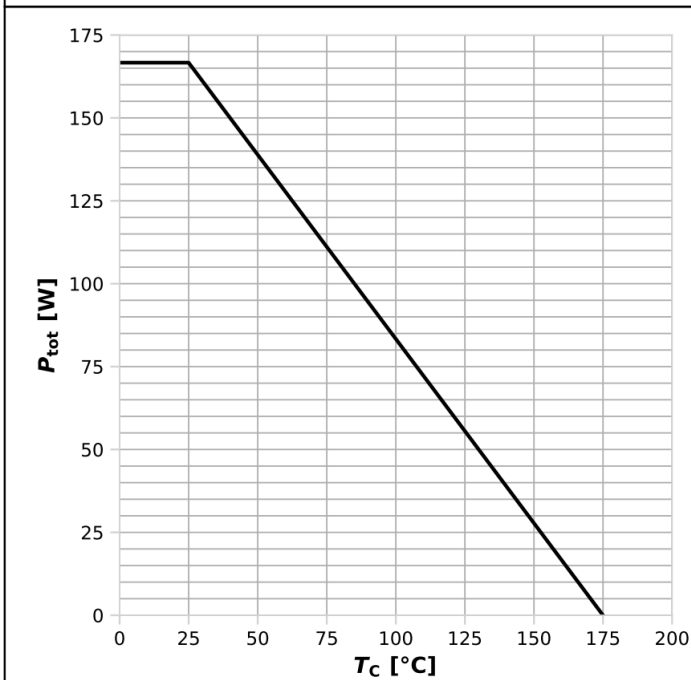
表 8 反向二极管特性

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test condition
		Min.	Typ.	Max.		
Diode continuous forward current	$I_S$	-	-	24	A	$T_C=25\text{ }^\circ\text{C}$
Diode pulse current	$I_{S,pulse}$	-	-	150	A	$T_C=25\text{ }^\circ\text{C}$ , $t_{pulse}\leq 250\text{ ns}$
Diode forward voltage	$V_{SD}$	-	3.5	4.3	V	$V_{GS}=0\text{ V}$ , $I_S=11.1\text{ A}$ , $T_J=25\text{ }^\circ\text{C}$
MOSFET forward recovery time	$t_{fr}$	-	11.5	-	ns	$V_R=200\text{ V}$ , $I_S=11.1\text{ A}$ , $di_S/dt=1000\text{ A}/\mu\text{s}$
			8.5			$V_R=200\text{ V}$ , $I_S=11.1\text{ A}$ , $di_S/dt=3000\text{ A}/\mu\text{s}$
MOSFET forward recovery charge <sup>9)</sup>	$Q_{fr}$	-	39	-	nC	$V_R=200\text{ V}$ , $I_S=11.1\text{ A}$ , $di_S/dt=1000\text{ A}/\mu\text{s}$
			77			$V_R=200\text{ V}$ , $I_S=11.1\text{ A}$ , $di_S/dt=3000\text{ A}/\mu\text{s}$

<sup>9)</sup>  $Q_{fr}$  包括  $Q_{oss}$ 。测试设置参见表 10。

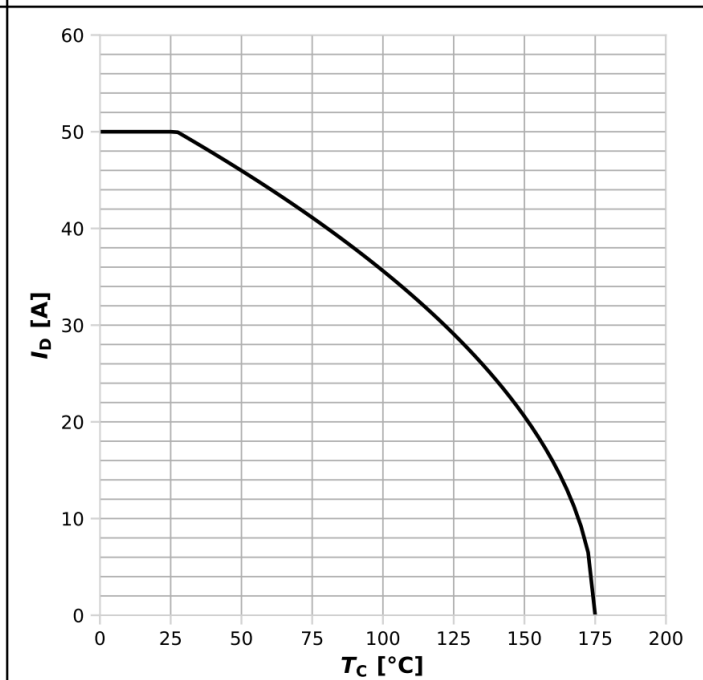
## 5 电气特性图

Diagram 1: Power dissipation



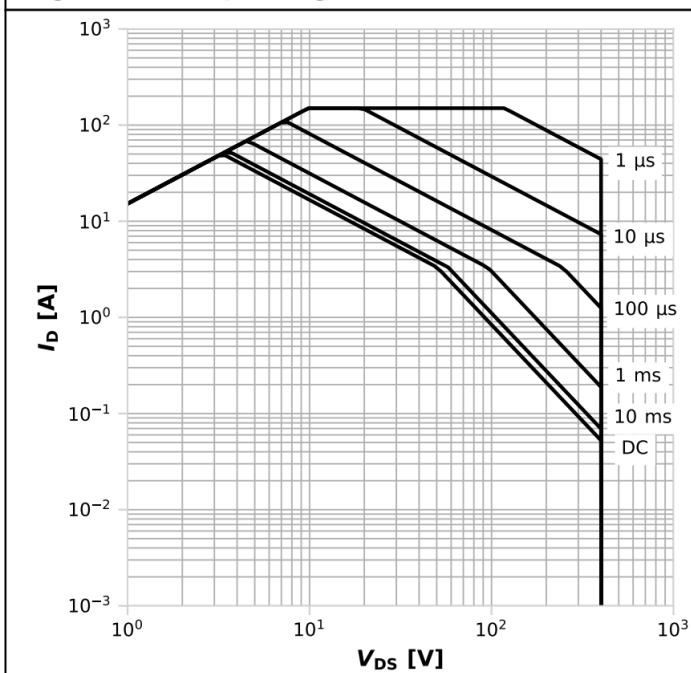
$$P_{tot}=f(T_c)$$

Diagram 2: Drain current



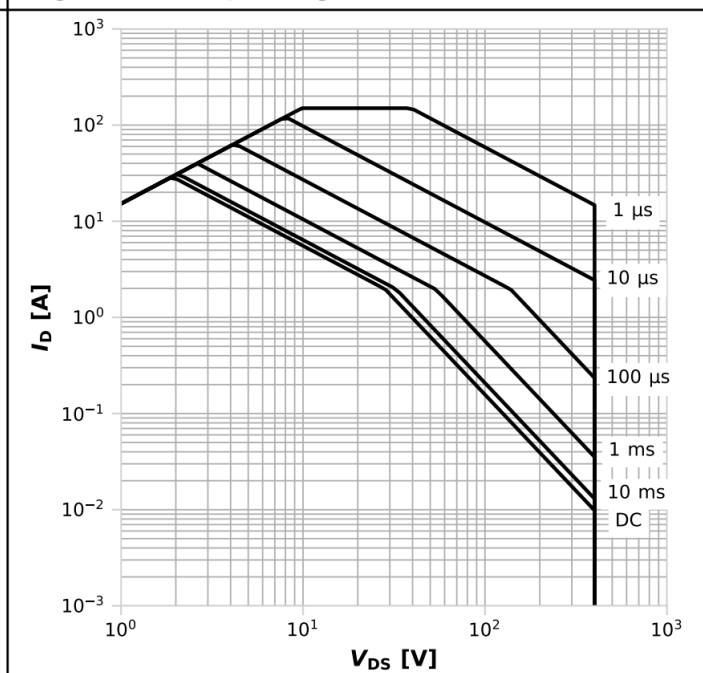
$$I_b=f(T_c); V_{GS} \geq 18 V$$

Diagram 3: Safe operating area



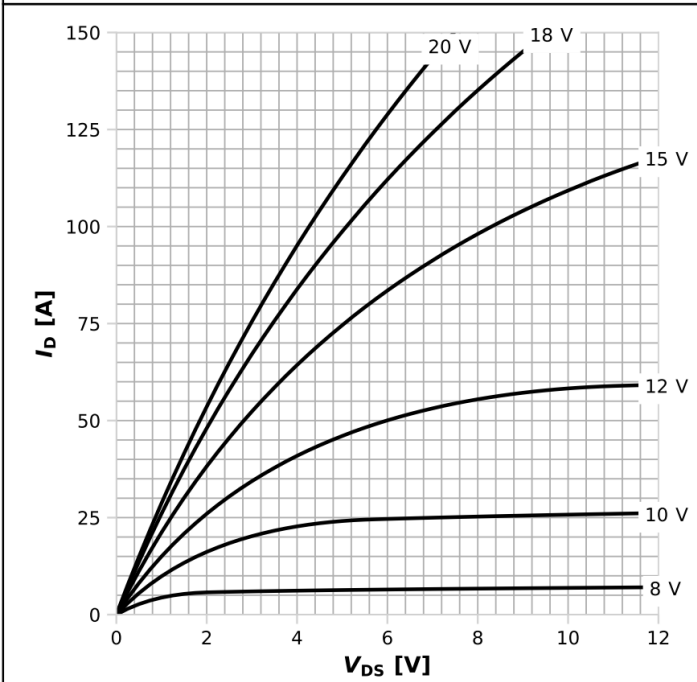
$$I_b=f(V_{DS}); T_c=25\text{ °C}; D=0; \text{parameter: } t_p$$

Diagram 4: Safe operating area



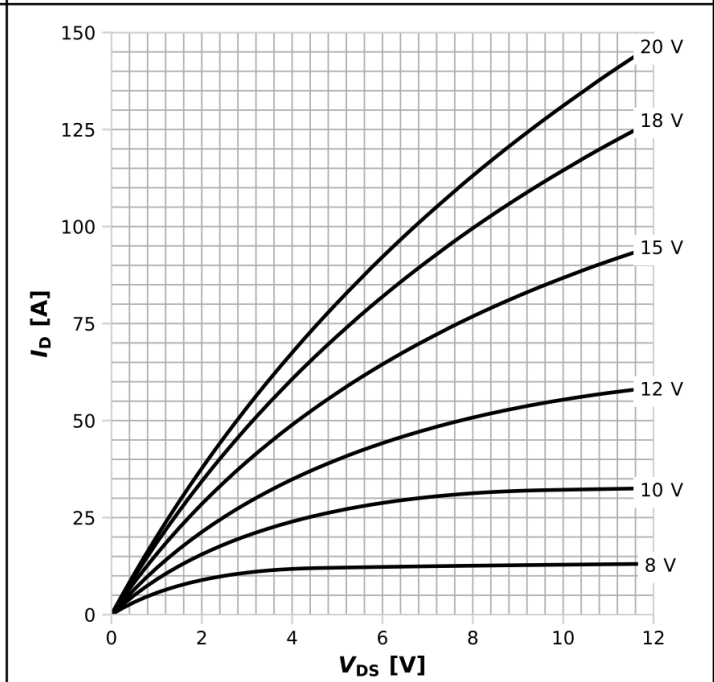
$$I_b=f(V_{DS}); T_c=125\text{ °C}; D=0; \text{parameter: } t_p$$

Diagram 5: Typ. output characteristics



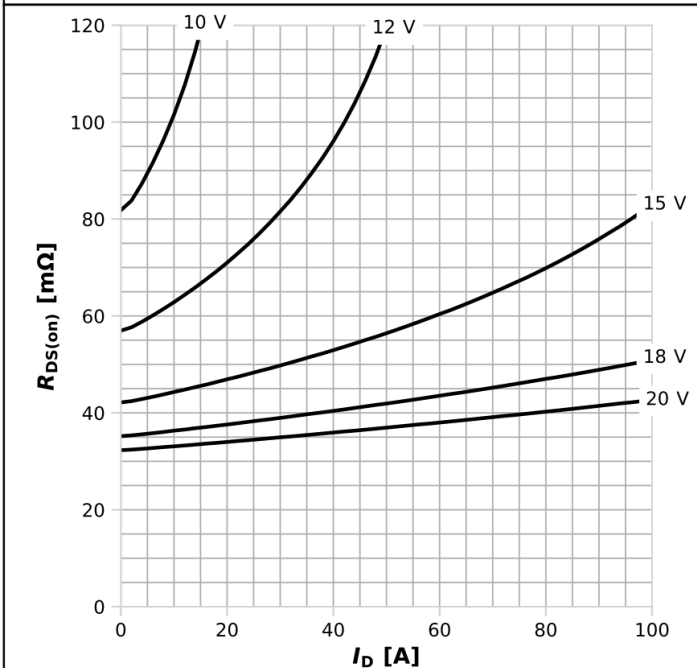
$I_D = f(V_{DS}), T_j = 25\text{ °C}; \text{parameter: } V_{GS}$

Diagram 6: Typ. output characteristics



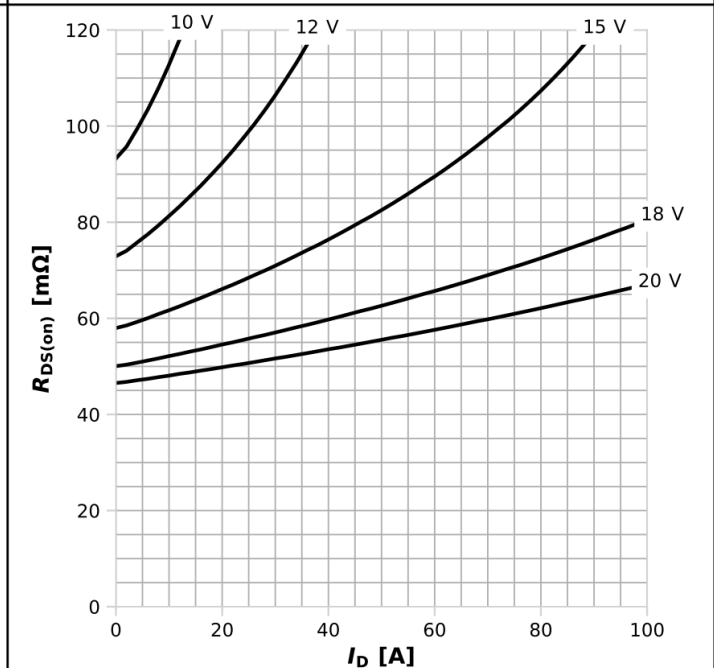
$I_D = f(V_{DS}), T_j = 175\text{ °C}; \text{parameter: } V_{GS}$

Diagram 7: Typ. drain-source on resistance



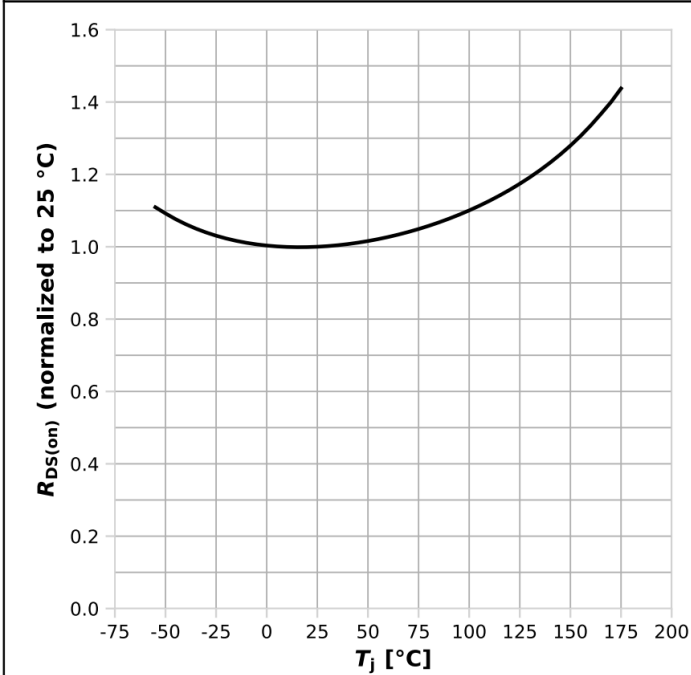
$R_{DS(on)} = f(I_D), T_j = 25\text{ °C}; \text{parameter: } V_{GS}$

Diagram 8: Typ. drain-source on resistance



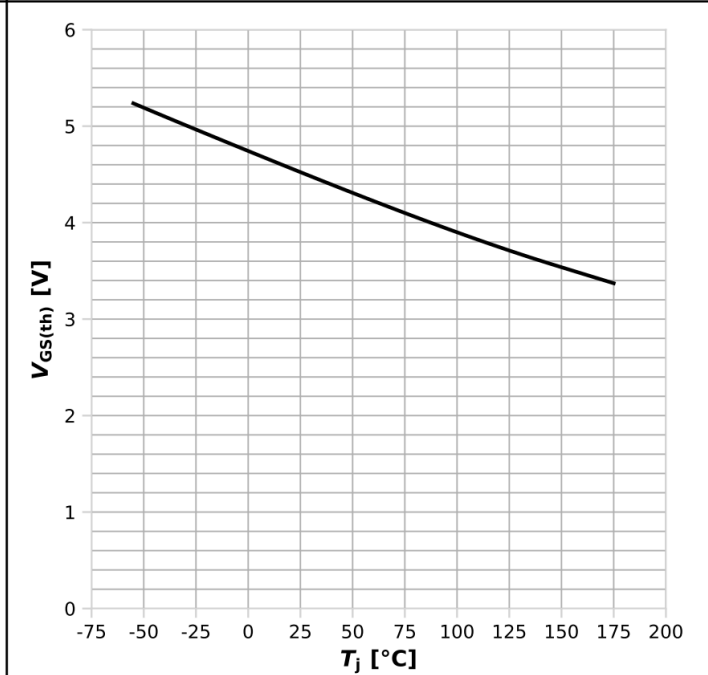
$R_{DS(on)} = f(I_D), T_j = 175\text{ °C}; \text{parameter: } V_{GS}$

Diagram 9: Normalized drain-source on resistance



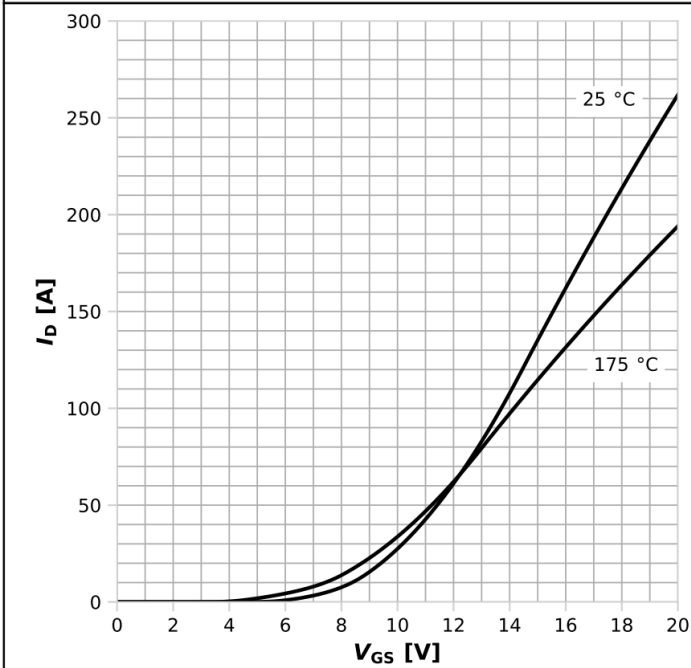
$R_{DS(on)}=f(T_j), I_D=11.1\text{ A}, V_{GS}=18\text{ V}$

Diagram 10: Typ. gate threshold voltage



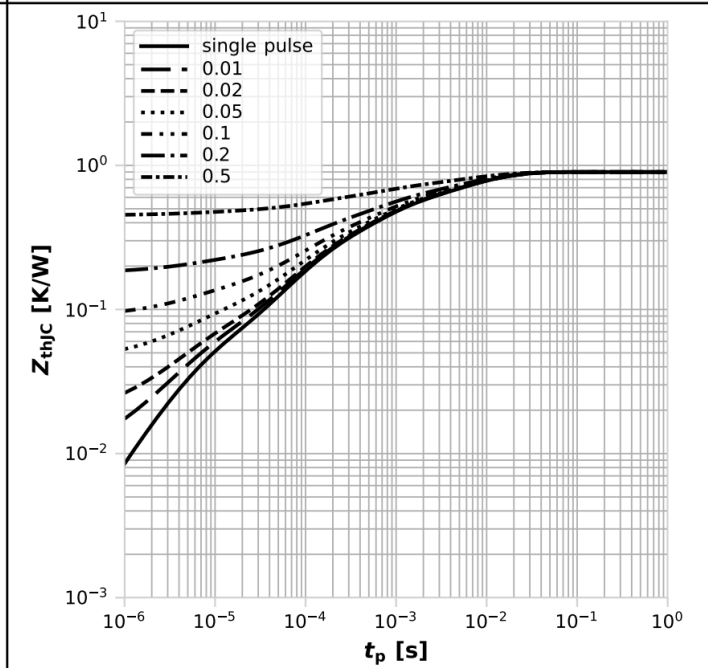
$V_{GS(th)}=f(T_j), V_{GS}=V_{DS}, I_D=4\text{ mA}$

Diagram 11: Typ. transfer characteristics



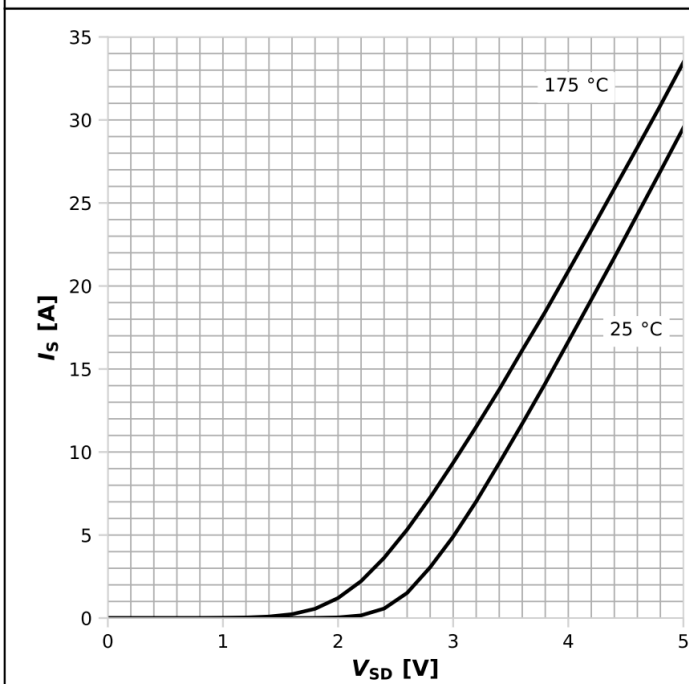
$I_D=f(V_{GS}), |V_{DS}|>2|I_D|R_{DS(on)max}; \text{parameter: } T_j$

Diagram 12: Max. transient thermal impedance



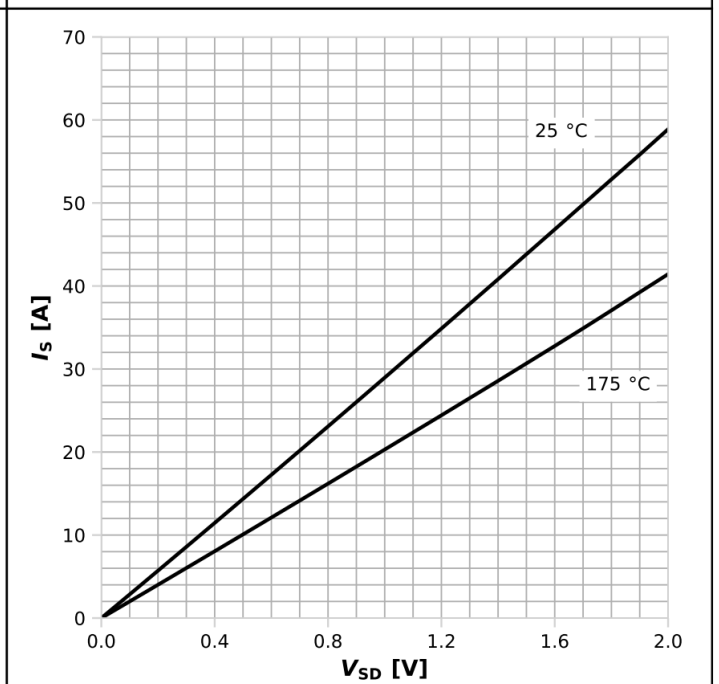
$Z_{thjC}=f(t_p); \text{parameter: } D=t_p/T$

Diagram 13: Reverse output characteristics



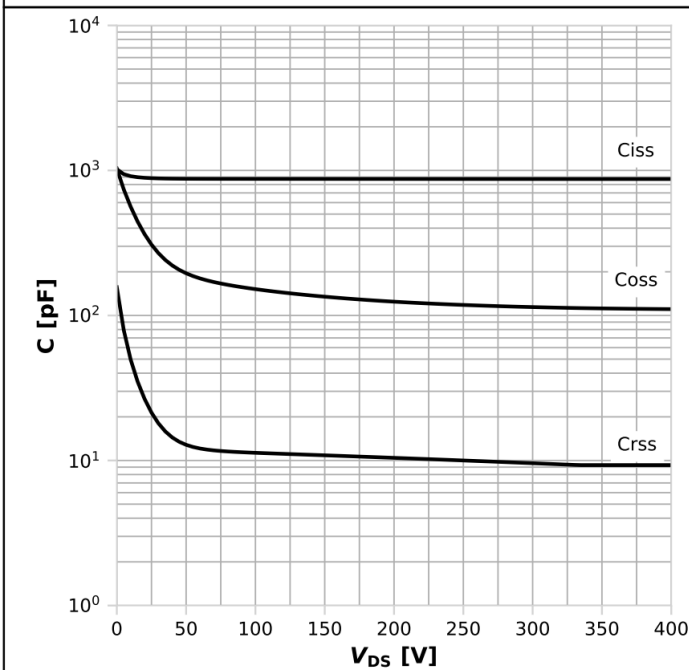
$I_F = f(V_{SD}), V_{GS} = 0 \text{ V}; \text{ parameter: } T_j$

Diagram 14: Reverse output characteristics



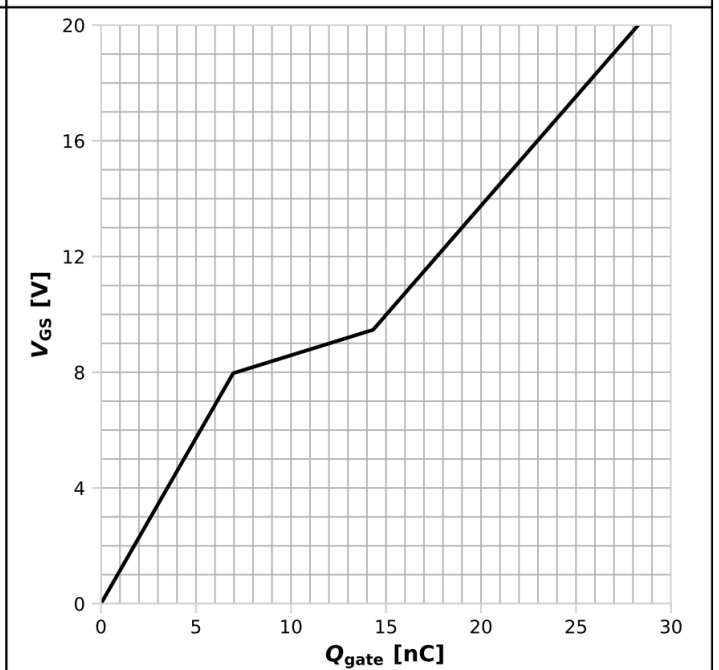
$I_F = f(V_{SD}), V_{GS} = 18 \text{ V}; \text{ parameter: } T_j$

Diagram 15: Typ. capacitances



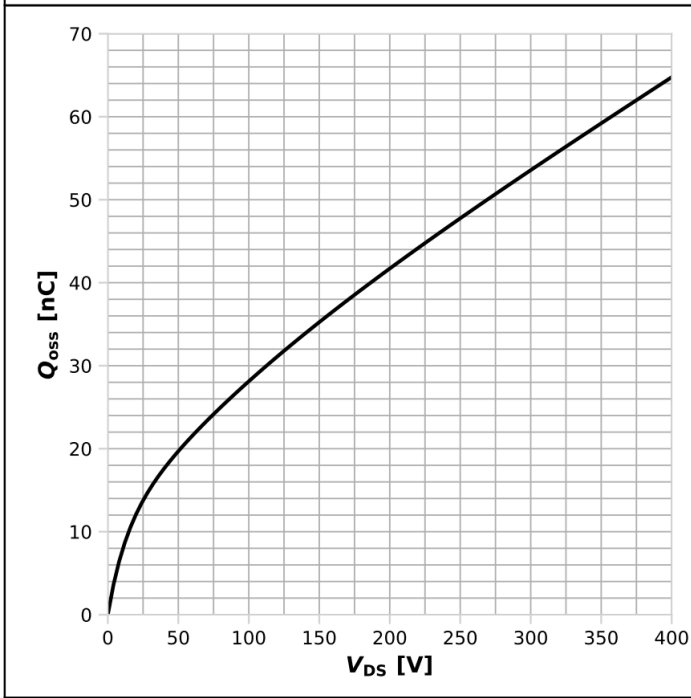
$C = f(V_{DS}); V_{GS} = 0 \text{ V}; f = 1 \text{ MHz}$

Diagram 16: Typ. gate charge



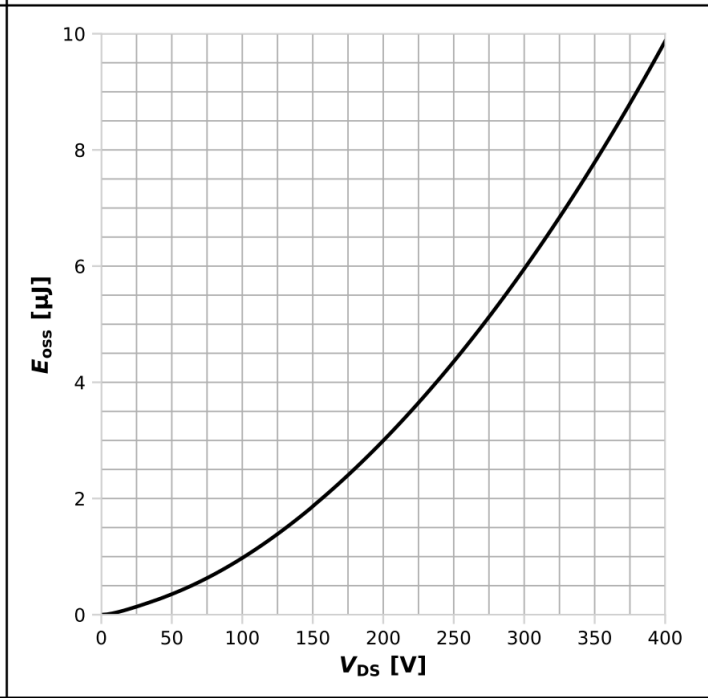
$V_{GS} = f(Q_{\text{gate}}), V_{DD} = 200 \text{ V}, I_D = 11.1 \text{ A pulsed}, T_j = 25 \text{ °C}$

Diagram 17: Typ. output charge



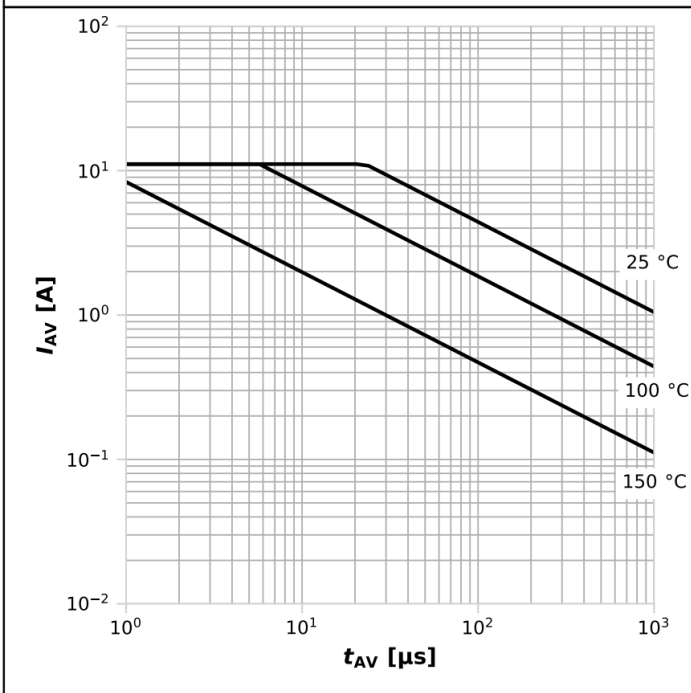
$Q_{oss}=f(V_{DS}), V_{GS}=0\text{ V}$

Diagram 18: Typ. output energy



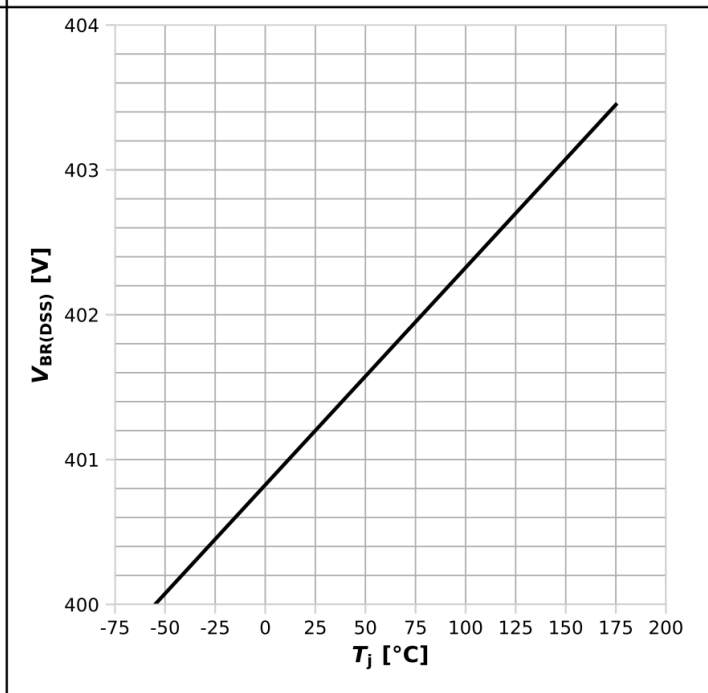
$E_{oss}=f(V_{DS}), V_{GS}=0\text{ V}$

Diagram 19: Avalanche characteristics



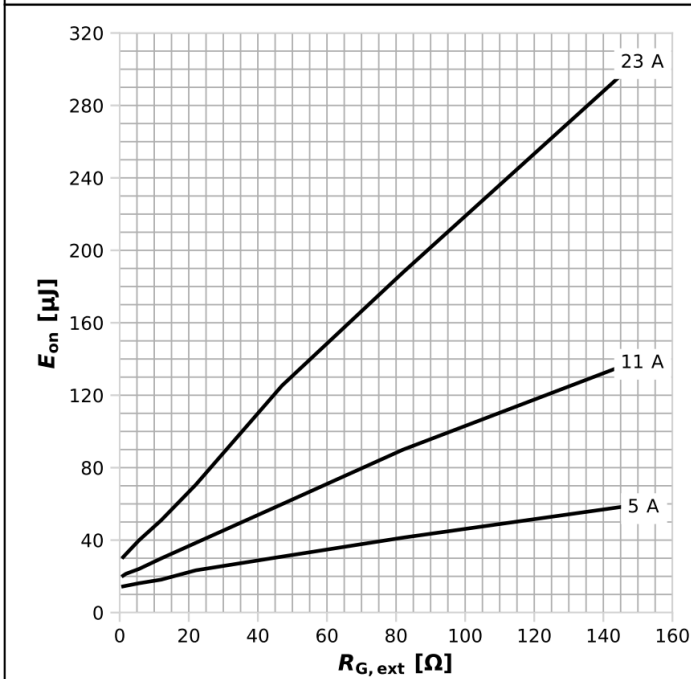
$I_{AS}=f(t_{AV}); R_{GS}=25\ \Omega; \text{parameter: } T_{j,\text{start}}$

Diagram 20: Min. drain-source breakdown voltage



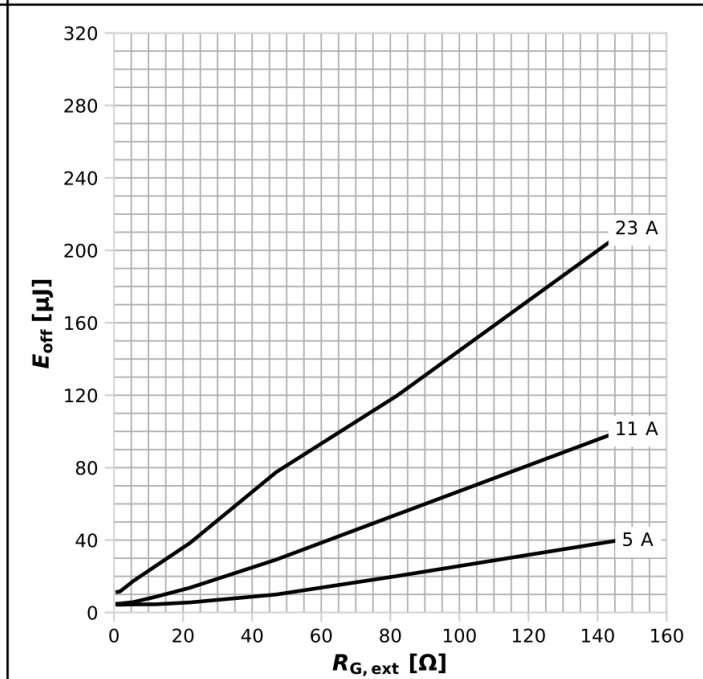
$V_{BR(DSS)}=f(T_j); I_D=0.4\text{ mA}$

Diagram 21: Typ. turn-on switching losses



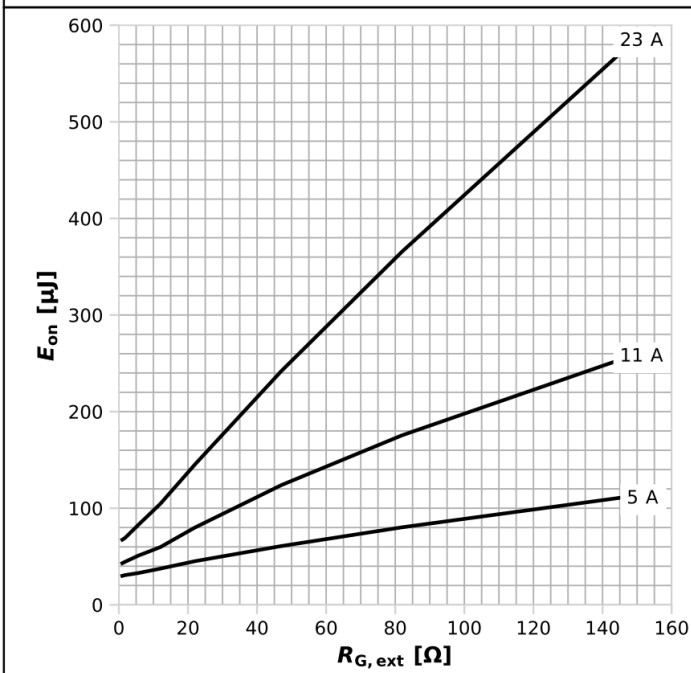
$$E_{on}=f(R_{g,ext}), V_{DD}=200\text{ V}, V_G=0\dots 18\text{ V}; \text{parameter: } I_D$$

Diagram 22: Typ. turn-off switching losses



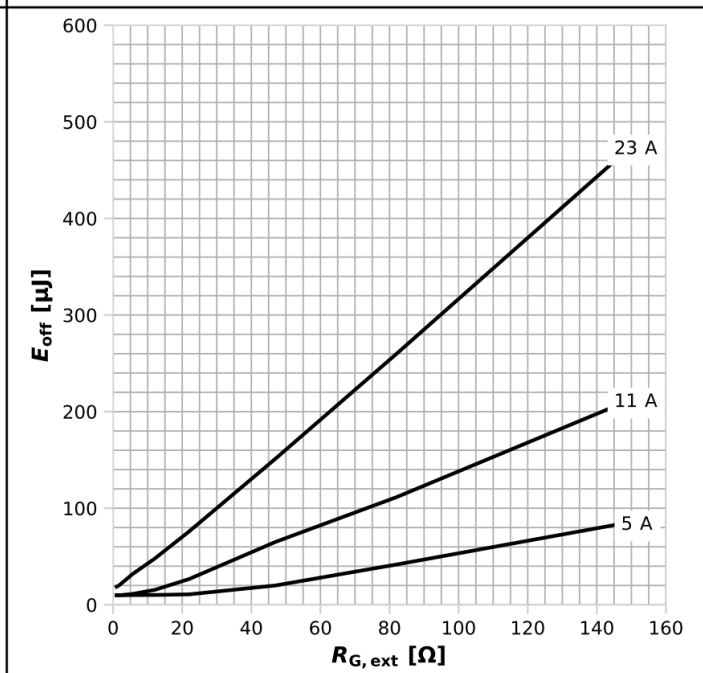
$$E_{off}=f(R_{g,ext}), V_{DD}=200\text{ V}, V_G=18\dots 0\text{ V}; \text{parameter: } I_D$$

Diagram 23: Typ. turn-on switching losses



$$E_{on}=f(R_{g,ext}), V_{DD}=320\text{ V}, V_G=0\dots 18\text{ V}; \text{parameter: } I_D$$

Diagram 24: Typ. turn-off switching losses



$$E_{off}=f(R_{g,ext}), V_{DD}=320\text{ V}, V_G=18\dots 0\text{ V}; \text{parameter: } I_D$$

## 6 测试电路

表 9 开关时间

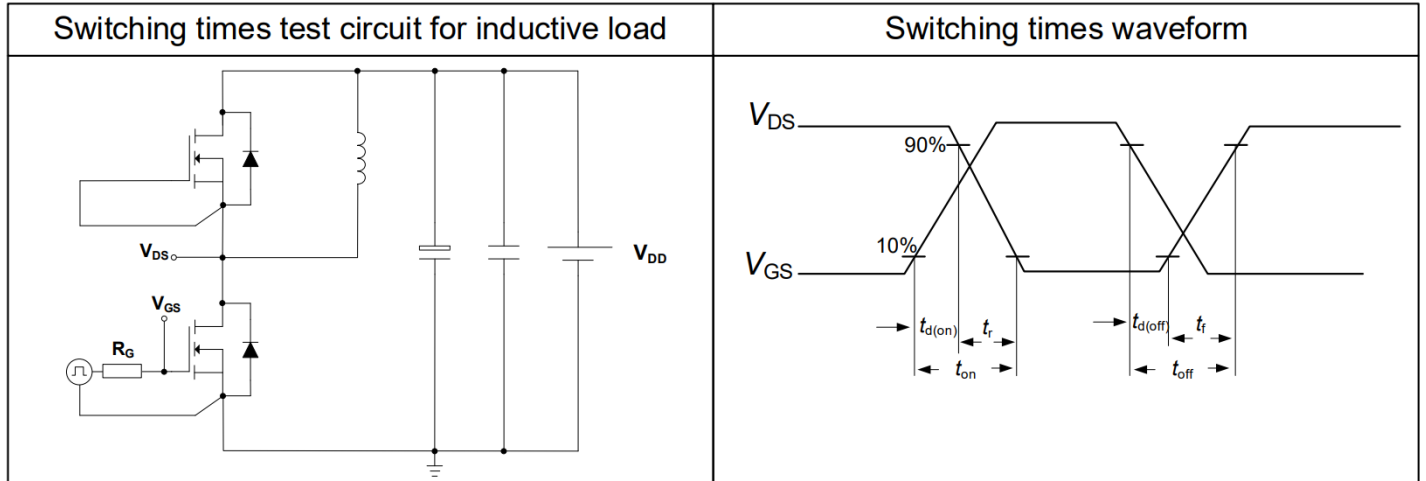
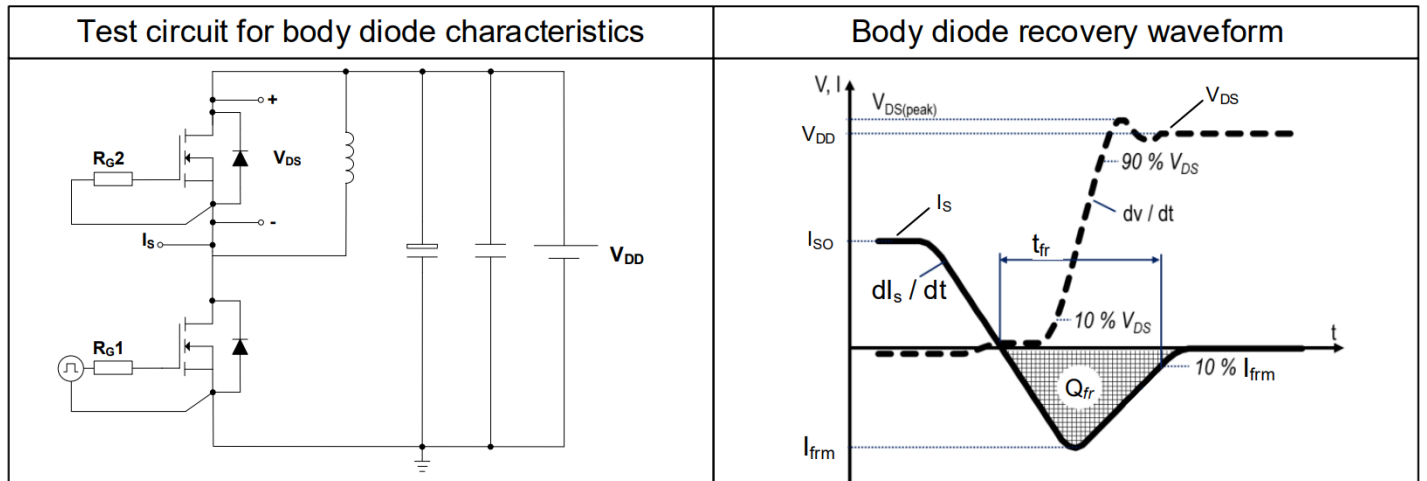


表10 体二极管特性



## 7 封装外形

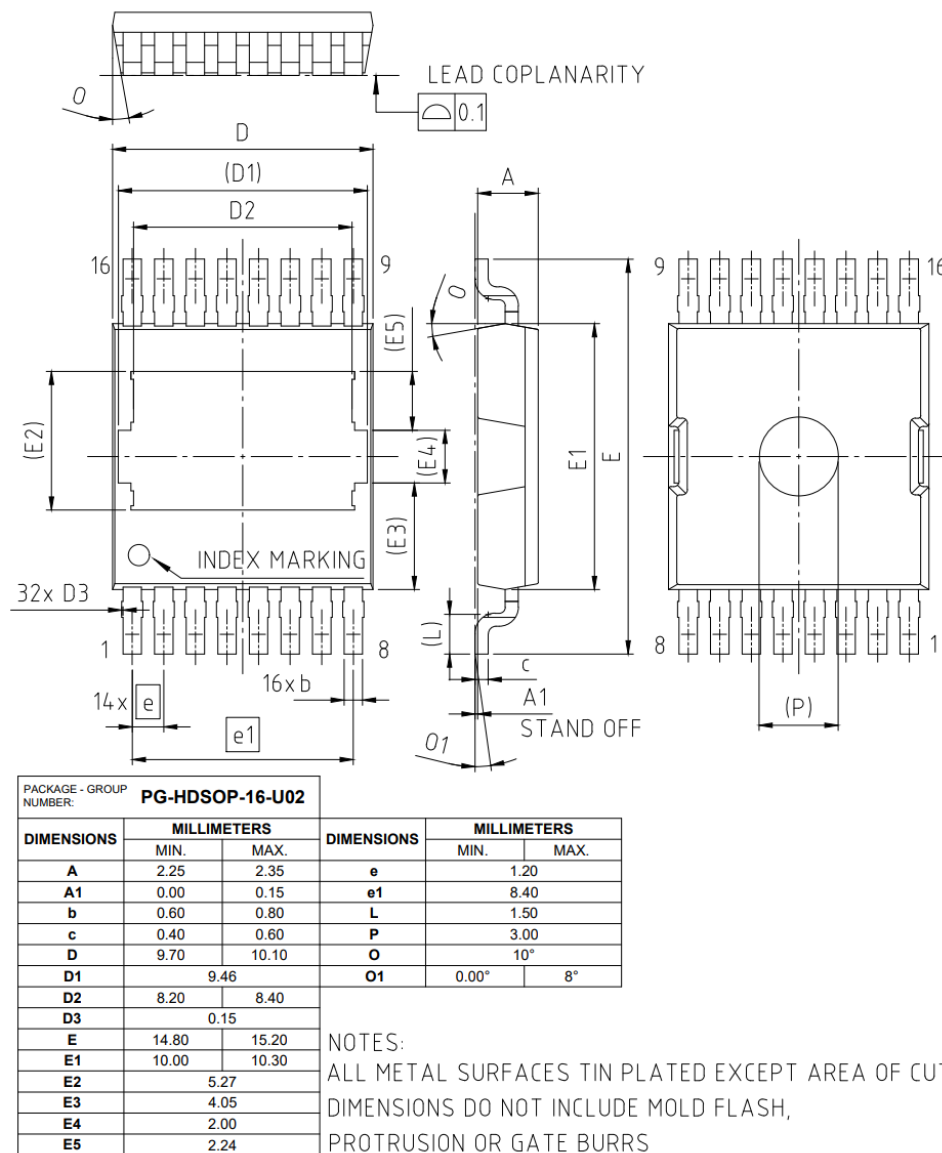


图 1 PG-HDSOP-16 外形图，尺寸单位为毫米

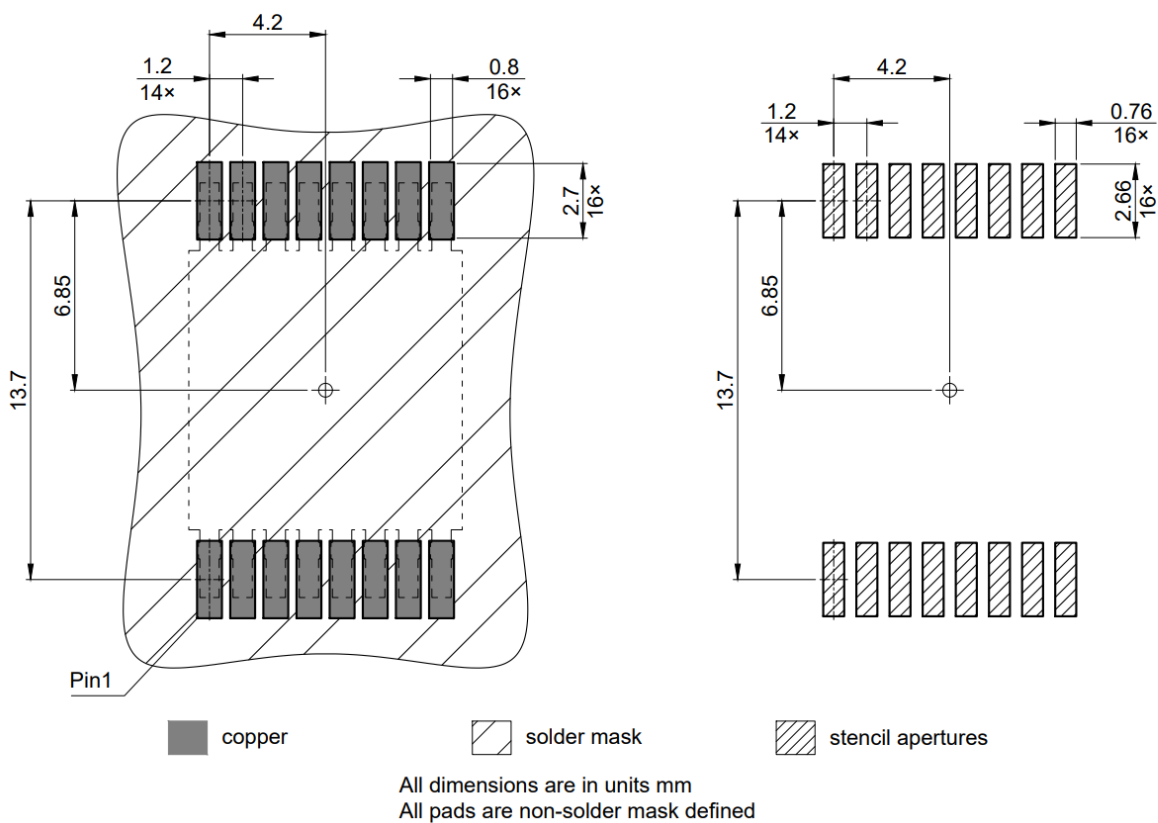
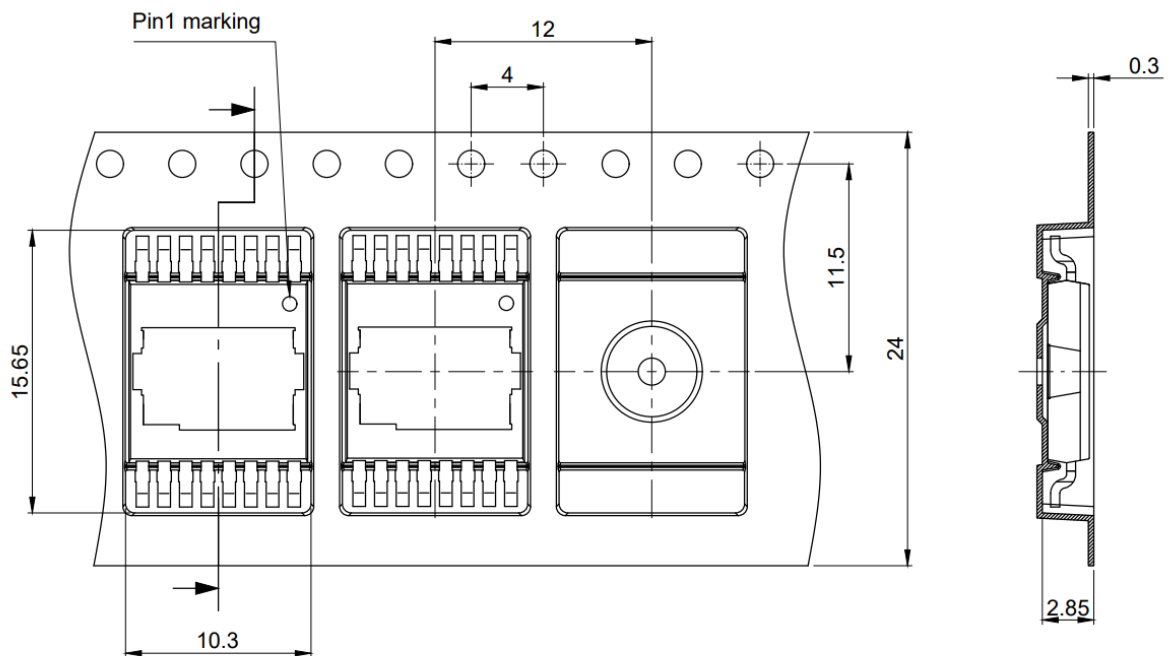


图 2 PG-HDSOP-16 封装图，尺寸单位为毫米



All dimensions are in units mm

The drawing is in compliance with ISO 128-30, Projection Method 1 [第一角法]

图 3 PG-HDSOP-16 包装型号，尺寸单位为毫米



修订记录

IMLT40R036M2H

Revision 2025 - 07 - 15 , Rev. 1 . 0

历史修订版本

Revision	Date	Subjects (major changes since last revision)
1.0	2025-07-15	Release of final datasheet



## 免责声明

请注意，本文件的原文使用英文撰写，为方便客户浏览英飞凌提供了中文译文。该中文译文仅供参考，并不可作为任何论点之依据。

由于翻译过程中可能使用了自动化程序，以及语言翻译和转换过程中的差异，最后的中文译文与最新的英文版本原文含义可能存在不尽相同之处。

因此，我们同时提供该中文译文版本的最新英文原文供您阅读，请参见 <http://www.infineon.com>

英文原文和中文译文版本之间若存有任何歧异，以最新的英文版本为准，并且仅认可英文版本为正式文件。

**您如果使用本文件，即表示您同意并理解上述说明。英飞凌不对因翻译过程中可能存在的任何不完整或不准确信息而产生的任何直接或间接损失或损害负责。英飞凌不承担中文译文版本的完整性和准确性责任。如果您不同意上述说明，请不要使用本文件。**

## Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

## 重要通知

版本 2026-02-12

Infineon Technologies AG 出版，  
德国 Neubiberg 85579

版权 © 2026 Infineon Technologies AG  
及其关联公司。  
保留所有权利。

**Do you have a question about this  
document?**

Email:  
[erratum@infineon.com](mailto:erratum@infineon.com)

Infineon Technologies AG 及其关联公司（以下简称“英飞凌”）销售或提供和交付的产品（可能也包括样品，且可能由硬件或软件或两者组成）（以下简称“产品”），应遵守客户与英飞凌签订的框架供应合同或其他书面协议的条款和条件，如无上合同或其他书面协议，则应遵守适用的英飞凌销售条件。只有在英飞凌明确书面同意的情况下，客户的一般条款和条件或对适用的英飞凌销售条件的偏离才对英飞凌具有约束力。

为避免疑义，英飞凌不承担不侵犯第三方权利的所有保证和默示保证，例如对特定用途/目的的适用性或适销性的保证。

英飞凌对与样品、应用或客户对任何产品的具体使用有关的任何信息或本文中给出的任何示例或典型值概不负责。

本文件中包含的数据仅供具有技术资格和技能的客户代表使用。客户有责任评估产品对预期应用和客户特定用途的适用性，并在预期应用和客户特定用途中验证本文件中包含的所有相关技术数据。客户有责任正确设计、编程和测试预期应用的功能性和安全性，并遵守与其使用相关的法律要求。

除非英飞凌另行明确批准，否则产品不得用于任何因产品故障或使用产品的任何后果可合理预期会导致人身伤害的应用。但是，上述规定并不妨碍客户在英飞凌明确设计和销售的使用领域中使用任何产品，但是客户对应用负有全部责任。

英飞凌明确保留根据适用法律，如《德国版权法》（UrhG）第 44b 条，将其内容用于商业资料和数据探勘（TDM）的权利。

如果产品包含安全功能：

由于任何计算设备都不可能绝对安全，尽管产品采取了安全措施，但英飞凌不保证产品不会被入侵、数据不会被盗或遗失，或不会发生其他漏洞（以下简称“安全漏洞”），英飞凌对任何安全漏洞不承担任何责任。

如果本文档包含或引用软件：

根据美国、德国和世界其他国家的知识产权法律和条约，该软件归英飞凌所有。英飞凌保留所有权利。因此，您只能按照软件附带的软件授权协议的规定使用本软件。

如果没有适用的软件授权协议，英飞凌特此授予您个人的、非排他性的、不可转让的软件知识产权授权（无权转授权）：(a) 对于以源代码形式提供的软件，仅在贵组织内部修改和复制该软件用于英飞凌硬件产品；及 (b) 对于以二进制代码 (binary code) 形式对外向终端用户分发该软件，仅得用于英飞凌硬件产品。禁止对本软件进行任何其他使用、复制、修改、翻译或编译。有关产品、技术、交货条款和条件以及价格的详细信息，请联系离您最近的英飞凌办公室或访问 <https://www.infineon.com>。